

凝聚态物理-北京大学论坛

等离子体刻蚀技术 在集成电路及泛IC产业中的发展

刘韶华 博士

Abstract: : Reduction of Standby current for all electronic application is the desire. While feature size keeps shrinking from 90nm to 65, 40, 28, 14nm, the increasing of device leakage become the major show stopper. This seminar will introduce a novel methodology to resolve the above problem and achieved improvement wafer yield by 50%.

刘韶华，北京大学物理系学士，美国马里兰大学物理系硕士，博士，曾在中欧国际工商学院学习企业战略管理。曾任美国先进燃料研究公司（AFR）资深科学家，美国英特尔公（INTEL）加州技术生产中心部门经理，上海宏力半导体（GSMC）副总裁，曾任北美中国半导体协会理事，中国科学院微系统所客座研究员，博士生导师。现任北京北方微电子公司副总裁，上海大学特聘教授。获美国专利多项，发表文章47篇。

时间：12月18日（星期四）15:00—16:40

地点：北京大学物理大楼中212教室

联系人：沈波 教授，邮箱：bshen@pku.edu.cn